文章编号: 0258-7025(2009)01-0070-07

# 激光二极管阵列抽运高增益钕玻璃棒状放大器

邓青华1,2 彭翰生3 高松信4 李明中1 丁 军4 王建军1 石1 雷 罗亦鸣1 唐 军1 林宏奂1 张 锐1 邓 颖1 卢振华1 ( 中国工程物理研究院 1 激光聚变研究中心,<sup>2</sup> 研究生部,<sup>3</sup> 院机关,<sup>4</sup> 应用电子学研究所,四川 绵阳 621900)

摘要 宽带高增益钕玻璃放大器在惯性约束聚变(ICF)激光驱动器研究中具有重要意义。对影响激光二极管阵列 (LDA) 抽运钕玻璃棒状放大器增益的各因素进行分析, 确立了放大器的优化参量。建立了模拟环形 LDA 侧面抽 运钕玻璃棒状放大器功率沉积过程的光线追迹模型,并开发相关程序。在模拟计算基础上,分别优化了 LDA 直接 耦合抽运和 LDA 准直耦合抽运这两种构型的放大器参数。最后引入了指向误差分析,比较了这两种耦合方式的 优劣,最终将放大器定为直接耦合抽运方式。按照优化后的结构加工了8.1 kW激光二极管抽运的约2 mm钕玻璃放 大器,放大器的荧光分布均匀,当抽运功率为7.7 kW时,得到了 40 倍的小信号增益,且放大器后增加偏振片时所测 增益稳定性较好。

关键词 激光器;激光二极管抽运固体激光器;侧面抽运;抽运耦合 中图分类号 TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20093601.0070

## Laser Diode Array Pumped High-Gain Nd Glass **Rod Amplifier**

Deng Qinghua<sup>1,2</sup> Peng Hansheng<sup>3</sup> Gao Songxin<sup>4</sup> Li Mingzhong<sup>1</sup> Ding Lei<sup>1</sup> Lei Jun<sup>4</sup> Wang Jianjun<sup>1</sup> Luo Yiming<sup>1</sup> Tang Jun<sup>1</sup> Lin Honghuan<sup>1</sup> Zhang Rui<sup>1</sup> Deng Ying<sup>1</sup> Lu Zhenhua<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laser Fusion Research Center, <sup>2</sup>Postgraduate Department, <sup>3</sup>Headquarter, <sup>4</sup>Applied Electronics Institute, China Academy of Engineering Physics, Mianyang, Sichuan 621900, China

Abstract Nd<sup>3+</sup>-doped phosphate glass amplifier with high gain and broad band is important in inertial confinement fusion (ICF) laser driver research. After analyzing all the factors which determine gain of a laser diode array (LDA) pumped Nd glass rod amplifier, the optimum parameters are presented. The ray-tracing model is set up to simulate the deposition process of LDA side-pumped Nd glass rod amplifier, and the relative program is developed. Based on the simulation, the structures of amplifiers without and with micro-lens are optimized. From the error analysis of LDA pointing, it is found out that the amplifier without micro-lens is more preferable. A rod amplifier with  $\phi$ 2 mm Nd glass and 8.1 kW pumping power is manufactured. The fluorescence distribution of the amplifier is uniform. As pumping power is 7.7 kW, the amplifier gain is 40. When a polarizer is added behind the amplifier, gain of the amplifier is very stable.

**Key words** lasers; diode pumped slid state laser; side pumping; pump power coupling

言 1 弓[

目前运行的惯性约束聚变(ICF)激光驱动器多 数采用窄带脉冲,然而这些高功率激光装置在缓解 B积分限制、抑制大口径光学元件内横向受激布里 渊散射(SBS)效应从而提高光束近场质量、结合束 匀滑技术改善光束远场分布等几个方面对宽带脉冲

收稿日期:2008-03-03; 收到修改稿日期:2008-06-27

作者简介:邓青华(1976—),女,博士研究生,主要从事高功率固体激光技术方面的工作。E-mail:dqhaj@yahoo.com.cn 导师简介:彭翰生(1936—),男,博士生导师,主要从事等离子体物理和超短激光技术方面的研究。

存在需求。美国 NIF 装置已在前端利用几个具有 不同技术指标的相位调制器分别满足这些需求<sup>[1]</sup>。 而我国新一代 ICF 激光驱动器拟采用宽带啁啾脉 冲进行时间编码得到所需纳秒脉冲的前端技术方 案,从而满足以上几方面对宽带脉冲的需求<sup>[2]</sup>。因 而新一代 ICF 激光驱动器建造过程中,如何增大整 个系统的放大带宽成了非常重要的研究课题。

高功率激光装置中的预放系统是一个重要环 节,其功能之一就是对前端输出的种子脉冲进行预 放大。当灵活方便的光纤前端纷纷被新一代高功率 固体激光驱动器采用后<sup>[3]</sup>,预放系统的预放大功能 显得更为突出。这是因为输出峰值功率的限制,从 光纤前端输出的种子光单脉冲能量很低,通常只有 纳焦耳~微焦耳水平。这种情况下,预放系统必须 提供更高的净增益(10<sup>6</sup>~10<sup>9</sup>)才能使注入主放大器 的激光脉冲达到数焦耳水平,从而能被主放大器有 效放大。因而预放系统中的宽带高增益放大问题必 须加以解决。本文主要就组成预放系统的关键高增 益放大器单元进行研究。

由于激光二极管阵列(LDA)抽运的固体激光 器具有高效率、高可靠性以及 LD 抽运源的长寿命 等优点,因而成为新一代固体激光器的主角<sup>[4~6]</sup>。 钕玻璃介质具有较好的光学均匀性、高的掺杂浓度、 合适的受激发射截面、大的增益带宽(大于20 nm), 是当今用于 ICF 研究高功率激光驱动器的最佳介 质。因而 LDA 抽运的钕玻璃放大器是解决预放系 统高增益宽带放大问题的首选方案。LDA 侧面抽 运放大器具有结构简单、耦合效率高等优点,因而本 文将 LDA 侧面抽运钕玻璃放大器作为研究重点。

### 2 LDA 侧面抽运钕玻璃放大器优化 设计

#### 2.1 放大器优化设计参量

由文献[7]可知,LDA 抽运放大器的小信号增 益可确定为

$$G_{0} = \exp\left(\frac{KP_{\text{pump}}}{AI_{s}}\right), \qquad (1)$$

式中 K 为由放大器抽运结构、增益介质吸收特性、 抽运光与主激光波长比等确定的效率参量; P<sub>pump</sub> 为 激光二极管阵列的抽运功率; A 为增益介质的横截 面积; I<sub>s</sub> 为增益介质的饱和光强, 其值确定为

$$I_{\rm s} = \frac{h\nu}{\sigma \,\tau},\tag{2}$$

式中 hv 为激光单光子能量, σ和 τ分别为增益材料

的受激发射界面和上能级荧光寿命。由于磷酸盐钕 玻璃材料的受激发射截面小( $3.9 \times 10^{-20} \sim 4.3 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$ ),上能级荧光寿命为 $330 \,\mu \text{s}$ 左右,所 以磷酸盐的饱和光强很大,不利于实现高增益。从 (1)式可以看出,要在磷酸盐钕玻璃实现高增益,只 有尽可能地增大效率参量 K,抽运功率  $P_{\text{pump}}$ 并尽可 能地减小增益介质的横截面积 A。考虑放大器的工 程可行性和实际光束传输问题,本文将钕玻璃介质 的尺寸定为 $\phi$ 2 mm;由于激光二极管的价格仍然比 较昂贵,所以不能一味地靠增大抽运功率来提高放 大器增益,而是应充分地优化放大器的抽运结构来 提高效率参量 K。效率参量 K 可表示为

$$K = \eta_{\rm T} \eta_{\rm a} \eta_{\rm u} \eta_{\rm fl} \,, \qquad (3)$$

式中 η<sub>T</sub> 为抽运光由 LDA 传输到增益介质的转移效 率,称为辐射传输效率;η<sub>a</sub> 为对进入增益介质内抽运 光的吸收效率;上能态效率 η<sub>a</sub> 为激光跃迁时发射的 功率与抽运带吸收的功率之比,也是量子效率和斯 托克斯效率的乘积,增益材料确定后,η<sub>a</sub> 值随之确 定;η<sub>a</sub> 为荧光效率,由于激光上能级粒子具有一定 的荧光寿命,上能级粒子会以自发辐射方式回到下 能级,由于研究的是脉冲放大器,信号光脉宽远小于 抽运脉宽,当信号光注入时,存留在上能级的粒子与 总的抽运到上能级的粒子数之比小于 1,该比值即 为荧光效率。荧光效率计算式为

 $\eta_{\Pi} = \tau/t \times [1 - \exp(-t/\tau)],$  (4) 式中 t 为抽运脉冲的宽度。抽运脉冲的宽度确定 后,在抽运脉冲结束时(亦为信号光注入时)的荧光 效率也随之确定。为了获得荧光效率和抽运总能量 乘积的最大值,通常让抽运脉宽略大于激光上能级 寿命。由此看来,能通过优化放大器结构来提高放 大器增益的是辐射传输效率  $\eta_{T}$  和吸收效率  $\eta_{a}$ ,因此 将这两项的乘积(称为抽运储能效率  $\eta_{deposit}$ )作为优 化参量之一;另外,放大器的增益均匀性也非常重 要。所以本文主要就提高放大器的抽运储能效率和 抽运均匀性来优化放大器结构。

#### 2.2 放大器抽运光强沉积模拟过程

激光二极管阵列侧面抽运放大器通常有两种抽运结构:一种是由数个激光二极管(LD bar)组成的抽运环直接对增益介质进行抽运;另一种是准直后的数个激光二极管组成抽运环抽运增益介质。这两种放大器的结构示意图如图1所示,(a)为激光二极管阵列直接抽运的钕玻璃放大器,(b)为激光二极管阵列准直后抽运的钕玻璃放大器。一般而言,当单个LD的发射功率很大时,会选用第一种抽运结

构,LD个数较少,能实现小的LD抽运环直径,从而 实现高的耦合效率;当单个LD的发射功率不是很 大时,则会选用第二种抽运结构,LD个数较多,LD 抽运环直径较大,由于LD输出的发散光经过微透 镜准直,也能实现高的耦合效率。两种结构中激光 二极管阵列慢轴方向与钕玻璃棒长度方向一致,忽 略激光二极管阵列慢轴方向的发散,则抽运光沿晶 体轴向是均匀的,只需要考虑钕玻璃横截面内的光 强分布即可。图1显示了两种抽运结构垂直于晶体 轴向一个截面内的情况。





Fig. 1 Scheme of Nd<sup>3+</sup>-doped phosphate glass amplifier without (a) and with micro-lens (b)

只考虑 LD 快轴方向的发散,而抽运光在快轴 方向随角度变化呈高斯分布,因而各 LD 输出的抽 运功率分布可表示为

$$P(\theta) = a \exp\left[-\left(\frac{\theta}{\theta_{\perp}/2}\right)^2 \ln 2\right], \qquad (5)$$

式中 $\theta_{\perp}$ 为激光二极管未准直或准直后的发散角,a为功率归一化常数,有

$$a = P_0 \Big/ \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \exp\left[-\left(\frac{\theta}{\theta_\perp}/2\right)^2 \ln 2\right], \quad (6)$$

式中 P<sub>0</sub> 为 LD 单位长度上的发射功率。

在计算整个增益介质内的抽运光强沉积分布 时,把增益介质的横截面用单元网格离散化,任一光 线在各网格内沉积的抽运功率为

$$P_{\rm ab} = P_{\rm in} [1 - \exp(-\alpha l)], \qquad (7)$$

式中 *P*<sub>in</sub> 为进入单元网格的抽运功率,α 为增益介质 对抽运光的吸收系数,*l* 为光线在网格内经过的路 径,可表示为

$$l = \sqrt{(x_{\rm out} - x_{\rm in})^2 + (y_{\rm out} - y_{\rm in})^2}, \qquad (8)$$

(x<sub>in</sub>,y<sub>in</sub>),(x<sub>out</sub>,y<sub>out</sub>)为光线在单元网格上入射点与 出射点的坐标。

实际的放大器中,为了对钕玻璃棒进行冷却,钕 玻璃棒外有去离子冷却水,水层外面有透明封水套 管。在计算钕玻璃棒截面内抽运光强沉积分布过程 中,忽略了棒表面和封水套管表面的反射损耗和水 层的吸收损耗,而只考虑它们对抽运光线的折射影 响。根据工程经验,水层厚度设计为1 mm,封水套 管的内径为ø4 mm,外径为ø5 mm。

增益介质的吸收系数与掺杂浓度有关,由于所

用钕玻璃棒的口径小,为了提高储能吸收效率,钕玻 璃材料的掺杂原子数分数较高,为3.3%,对802 nm 抽运光的吸收系数为6.5 cm<sup>-1</sup>。

利用(5),(6)式各 LD 的抽运光按角度离散化, 然后追踪每一条光线在介质内的传播路径,再利用 (7),(8)式计算各光线在传输过程中沉积在路径上 各单元的功率,就可以计算出整个介质内的抽运光 强分布。

#### 2.3 放大器抽运结构优化

先分别就图1所示的两种抽运结构参数进行优 化,然后再对优化好的两种结构进行比较,从中得到 最优抽运结构。

LDA 直接抽运构型中,抽运储能效率随着激光 二极管阵列组成的抽运环直径增大而减小,如图 2 所示。因而为了获得高的抽运储能效率,激光二极



Fig. 2 Deposition efficiency varying with diameter as LDA pumping ring directly

管抽运环的直径应尽可能小。因为封水套管的外径 为 \$5 mm,所以激光二极管抽运环的直径优化为 5.5 mm。在这种条件下,旋转对称分布的激光二极 管个数不同,钕玻璃棒内的抽运光强分布也不同,如 图 3 所示。为了不因相对辐照而影响激光二极管寿 命,将 LD 的个数均设计为奇数。由图 3 可知,随着 LD 个数的增加,钕玻璃棒内的抽运光强分布越均 匀。当 LD 增至 9 个时,抽运光强分布已很均匀,因 而 LD 的个数优化为 9。

激光二极管阵列准直后抽运构型中,由于LD



图 3 直接抽运结构中不同 LD bar 个数时钕玻璃棒内的抽运光强分布

Fig. 3 Pumping power distribution varying with number of LD bar changing

准直后的发散角大小控制与抽运环直径设计在提高 抽运储能效率和改进增益介质内的抽运光强分布方 面具有相同功能,因而在优化过程中,将抽运环直径 固定为14.5 mm而只优化准直发散角。LD个数定 为17,准直发散角变化时抽运储能效率和钕玻璃棒 内的抽运光强分布分别如图4,图5所示。由图4,5 可知,随着准直发散角的增大,抽运储能效率降低, 钕玻璃棒的光强分布变均匀;当准直发散角为15° 时,钕玻璃棒内的抽运光强分布已很均匀,此时的抽



图 4 LD 准直发散角变化时抽运储能效率的变化曲线 Fig. 4 Deposition efficiency of pumping power varying with collimating angle

运储能效率约为 60%。因而在第二种抽运构型中,将 LD 的准直发散角优化为 15°。

比较图 2~5 可知,激光二极管阵列直接对钕玻 璃棒进行抽运构型中,当抽运环直径为5.5 mm,LD 个数为9个时,可在钕玻璃棒内取得均匀的抽运光 强分布,抽运储能约为60%;而在激光二极管阵列 准直后对钕玻璃棒进行抽运构型中,当抽运环直径 为14.5 mm, LD个数为17个, 发散角为15°时, 也可 在钕玻璃棒内取得均匀的抽运光强分布,抽运储能 也约为60%。其实,在模拟计算过程中,还有两个 现实存在的方面没有考虑:其一是用微透镜对 LD 进行准直时均会引入损耗,所以激光二极管阵列准 直后抽运这种构型的抽运储能效率会更低;其二是 以上所有计算都是在理想情况下进行的,即所有 LD 都理想指向钕玻璃棒的中心,但由于机械加工 误差、封装误差等的存在,这种理想情况根本不存 在。当 LD 指向偏离钕玻璃棒中心时,两种优化后 的抽运结构能实现的抽运储能效率对比结果如图 6 所示。由图 6 可知,激光二极管阵列准直后抽运这 种构型对指向误差更敏感。而由于准直过程中微透 镜与 LD 线存在精确对准调整环节,这一环节容易

引起光束指向的偏离,所以实际封装过程中这一种 构型中的光束指向偏离误差相对第一种构型会更 大,从而可以推断这种构型放大器的抽运储能效率 会比理想计算值有较大降低。基于以上两个现实原 因可以得出结论:优化后的激光二极管阵列直接抽 运放大器的结构为最佳结构。



图 5 LD 准直发散角变化时钕玻璃棒内抽运光强的分布图 Fig. 5 Pumping power distribution varying with LD collimating angle





Fig. 6 Deposition efficiency varying with deviating angle of LDA pumped rod amplifier of Nd<sup>3+</sup>-doped phosphate glass without and with micro-lens

### 3 高增益钕玻璃放大器实验研究

依据优化结果,设计加工了9边抽运的激光二 极管抽运钕玻璃放大器。放大器由6个抽运环组 成,每个抽运环具有正9边形结构,由9个LD和镀 金铜块组成,镀金铜块的作用是反射对面透射或从 棒侧面漏泄过来的抽运光,进而形成二次或多次反 射而增大系统抽运储能效率。抽运环的结构示意图 如图7所示。每个LD长度为1 cm,抽运功率为 150 W,则放大器总的抽运功率为8.1 kW。放大器



图 7 抽运环结构示意图

Fig. 7 Pumping structure of the amplifier

总长为85 mm, 增益介质为 $\phi$ 2 mm, 长85 mm的 LHG-8型磷酸盐钕玻璃, 荧光寿命为320  $\mu$ s, 受激 发射截面为4. 2×10<sup>-20</sup> cm<sup>-2</sup>。

利用荧光光谱仪测试了放大器的荧光分布,如 图 8 所示。由图可知,经过优化设计, 42 mm放大器 中的抽运光强分布均匀;所测的抽运光强分布与图 3 中 N = 9 时的模拟计算结果吻合得很好。

将 1 Hz,30 μJ,3 ns,口径为¢1 mm的脉冲光源 作为小信号种子光,用行波法测试了放大器的小信 号增益。当激光二极管冷却水温为16 ℃,信号光相 对抽运脉冲上升沿延时350 μs时所测到的小信号增 益如图 9 所示。图 9 中同时给出了小信号增益理论



图 8 \$\nother 2 mm钕玻璃放大器的荧光分布图 Fig. 8 Fluorescence distribution of \$\nother 2 mm Nd^{3+}-doped phosphate glass amplifier



图 9 \$2 mm钕玻璃放大器的增益曲线 Fig. 9 Gian of \$2 mm Nd<sup>3+</sup>-doped phosphate glass amplifier



图 10 LDA 发射光谱图 Fig. 10 Emitting spectra of LDA

计算结果,增益理论计算过程中除了考虑光线追迹 计算所得的 60%抽运耦合外,还考虑了封水套管和 棒侧面对抽运光的反射损耗,取为 8%。由图 9 可 知,当抽运功率为7.7 kW时,放大器小信号增益可 达 40 倍;当抽运功率较小时,实验测试增益与理论 计算结果吻合;当抽运功率较大时,放大器的增益增 长偏离了理论计算结果。这是由于抽运功率较大 时,LD 积温升高,发射频谱中心红移(如图 10 所 示),抽运中心波长偏离钕玻璃材料的吸收峰值,吸 收效率降低,抽运储能效率随之下降,最终使得增益 偏离指数增长规律。

由图 10 可知,LDA 的发射频谱分布是半峰全 宽为3 nm的高斯型分布,当电流为60 A时,光谱中 心为802.52 nm;随着电流的增加,高斯分布中心红 移,中心移动速度约为0.021625 nm/A。尽管 LDA 的发射谱很窄,但毕竟有一定带宽及一定的分布。 为了能准确而快速地求出钕玻璃增益介质对 LDA 抽运光的吸收情况,一种简便方法就是求出钕玻璃 增益介质对 LD 发射谱的等效吸收系数。从而将 LDA 抽运光看作单色光,而钕玻璃增益介质对其的 吸收系数为该等效吸收系数。图 11 显示了所用钕 玻璃材料在802 nm附近的吸收曲线。由图可知,吸 收曲线以802 nm为中心,半峰全宽为13 nm。假设 LDA 发射谱分布为 ρdiode(λ),而钕玻璃介质的吸收 谱分布为α(λ),则钕玻璃增益介质对 LD 发射谱的

$$\alpha_{\rm eq} = \int \! \rho_{\rm diode}(\lambda) \times \alpha(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda / \! \int \! \rho_{\rm diode}(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda \, .$$
(9)

将不同电流下的等效吸收系数与光线追迹过程 结合起来,求出不同电流下的抽运储能效率,在此基 础上计算不同电流(即不同抽运功率)条件下的理论 增益。计算所得的理论增益与实验结果比较如图 12 所示。由图可知,考虑 LD 阵列发射频谱中心随 电流变化后计算所得的理论增益与实验结果吻合较 好。





Fig. 11 Absorption curve of  $\operatorname{Nd}^{\operatorname{3+}}\operatorname{-doped}$  phosphate glass

在放大器后加偏振片,测试放大器的偏振增益 稳定性,测试结果如图 13 所示。由图可知,激光放 大器工作10 min后进入稳定状态,此后随着工作时 间的延长,增益起伏变化很小。这表明由于\$2 mm 钕玻璃放大器中的增益介质直径小,且被充分水冷, 因热沉积而产生的退偏效应及增益变化不明显。 中





Fig. 12 Experimental gain versus theoretical gain of  $\phi$ 2 mm Nd<sup>3+</sup>-doped phosphate glass considering LDA emitting peak changing with different currents





### 4 结 论

对宽带高增益钕玻璃放大器进行了设计和实验 研究。对影响放大器增益的各因素进行了分析,得 出能通过结构优化来提高传输效率  $\eta_{\rm T}$  和吸收效率  $\eta_{\rm a}$ 从而提高放大器增益,并将这两项的乘积(称为抽 运储能效率  $\eta_{\rm deposit}$ )和增益均匀性作为优化参量。 建立了模拟环形激光二极管阵列侧面抽运钕玻璃棒 状放大器功率沉积过程的光线追迹模型,并开发了 相关程序,在模拟计算基础上,将 LDA 直接耦合抽 运构型的放大器优化为:旋转对称分布的 9 个 LD 能实现钕玻璃棒内均匀的抽运光强分布,抽运环直 径为5.5 mm时能实现 60%的抽运储能效率;而在 LDA 准直后对钕玻璃棒进行抽运构型中,当抽运环 直径为14.5 mm,LD 个数为 18 个,发散角为 15°时, 也可在钕玻璃棒内取得均匀的抽运光强分布,抽运 储能也约为60%。然而由于准直透镜的损耗,后者 的抽运储能效率会更低;后者对 LD 光束指向误差 也更敏感,由此将放大器定为直接耦合抽运方式。 按照优化后的结构加工了8.1 kW激光二极管抽运 的ø2 mm钕玻璃放大器,放大器的荧光分布均匀,当 抽运功率为7.7 kW时,得到了 40 倍的小信号增益。 然而当抽运功率增大时,由于 LDA 发射波长红移 而影响了抽运储能效率,最终导致增益增长偏离了 指数规律。所以应改进 LDA 的冷却结构,提高制 冷效率,抑制 LDA 发射波长红移而进一步提高增 益;加偏振片后所测得的增益曲线表明,10 min后放 大器进入稳定工作状态,此后增益稳定。本文设计 及加工的钕玻璃放大器具有抽运场均匀、高耦合效 率、高增益、增益稳定、能重复频率工作等特点,在新 一代惯性约束聚变驱动器中可以通过选取适当的光 路构型对光纤前端输出的种子光实现高倍率放大。

#### 参考文献

- J. W. Peter, W. B. Mark, V. E. Gaylen *et al.*. NIF injection laser system [C]. SPIE, 2004, 5341:146~155
- 2 Hu Zhengliang, Hu Yongming, Zhao Minghui *et al.*. Analysis and simulation of optic fiber-pulse stacker [J]. Acta Photonica Sinica, 2006, **35**(7):966~969 胡正良,胡永明,赵明辉等. 光纤脉冲堆积器的模拟分析[J]. 光子学报, 2006, **35**(7):966~969
- 3 Lin Honghuan, Wang Jianjun, Sui Zhan *et al.*. Integrated all fiber optical pulse generation system for laser fusion driver [J]. *Aata Physica Sinica*, 2008, **57**(3):470~474 林红奂,王建军,隋 展等. 用于激光聚变驱动器的全光纤、全 固化光脉冲产生系统[J]. 物理学报, 2008, **57**(3):470~474
- 4 Tian Yubing, Tan Huiming, Cao Hongzhong et al.. Low power laser diode-pumped solid-state Yb : YAG laser at room temperature [J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(5):633~636 田玉冰,檀慧明,曹洪忠 等. 低功率激光二极管抽运的室温运 转 Yb:YAG 激光器[J]. 中国激光, 2007, 34(5):633~636
- 5 Wang Wei, Liu Xingang, Liu Yingtong. Laser diode pumped Nd: NYW/LBO green laser [J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34 (5):646~648

王 巍,刘炘钢,刘英同.激光二极管抽运的 Nd:NYW/LBO 绿 光激光器[J]. 中国激光,2007,**34**(5):646~648

6 Jia Wei, Hu Yongming, Li Mingzhong et al.. Simulation and design of hollow lens duct as a new kind of coupling system for high power laser diode arrays [J]. Chinese J. Lasers, 2004, 31 (8): 939~942

贾 伟,胡永明,李明中 等. 空心透镜导管的模拟与设计[J]. 中国激光, 2004, **31**(8):939~942

7 W. Koechner. Solid-State Laser Engineering [M]. Beijing: Science Press, 2002

W. 克希耐尔. 固体激光工程[M]. 北京:科学出版社, 2002